

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【公開番号】特開2013-16635(P2013-16635A)

【公開日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【年通号数】公開・登録公報2013-004

【出願番号】特願2011-148288(P2011-148288)

【国際特許分類】

H 01 L 21/205 (2006.01)

H 01 L 21/31 (2006.01)

C 23 C 16/458 (2006.01)

H 01 L 21/22 (2006.01)

H 01 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/205

H 01 L 21/31 E

C 23 C 16/458

H 01 L 21/22 5 1 1 G

H 01 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】平成26年7月1日(2014.7.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板が載置された載置体と、

前記載置体が複数支持された載置体支持具と、

前記載置体支持具が収容される反応管と、

前記反応管の外側に設けられ、前記反応管内に収容された基板を加熱する加熱部とを備え、

前記載置体の、前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面が、同じ粗さに表面加工されたことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

前記載置体は、前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面が、同じ加工方法によって加工される請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記載置体の前記基板と接触する面と、前記載置体支持具と接触する面との表面粗さはRa = 1.5 ~ 2.5 μmとなる請求項1または2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面は、機械研磨加工またはプラスチック加工によって形成される請求項1~3のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項5】

載置体上に基板を載置する基板載置工程と、

載置体を載置体支持具に複数支持する載置体支持工程と、

基板が載置された載置体支持具を反応管内に収容する載置体支持具収容工程と、

前記反応管内に収容された載置体支持具が支持する載置体上に載置された基板を熱処理する熱処理工程とを備え、

前記基板載置工程より前に、前記載置体の前記基板と接触する面と前記載置体支持具と接触する面を、同じ粗さに表面加工することを特徴とする半導体装置の製造方法。